# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-347497

(43)Date of publication of application: 18.12.2001

(51)Int.Cl.

3/00

(21)Application number: 2000-168445

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

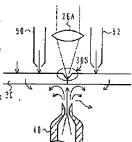
06.06.2000

MATSUMOTO TAKASHI (72)Inventor:

# (54) CUTOFF METHOD AND DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cutoff device having a minimized cutting error in manufacture and improved in yield of manufacture in a scribe type substrate cutoff method for forming a groove on the surface of a substrate and cutting of the substrate along the groove. SOLUTION: A scribe groove 30S is formed on the surface of a work 30. A pressurization nozzle 40 blows pressurized air to the part of the scribe groove 30 from the reverse side of the work 30. Pressurization nozzles 50 and 52 blow pressurized air to both sides of the scribe groove 30S from the surface side of the work 30. The work having ? C the scribe groove formed on the surface is thus cut off along the scribe groove.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection1

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-347497 (P2001-347497A)

(43) 公開日 平成13年12月18日(2001.12.18)

(51) Int.Cl.7	
B 2 6 F	3/00

識別記号

FΙ B 2 6 F 3/00

テーマコート\*(参考) A 3C060

## 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

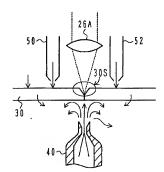
特顧2000-168445(P2000-168445)	(71)出職人	000005108 株式会社日立製作所
平成12年6月6日(2000.6.6)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
	(72)発明者	松本 隆
		神奈川県秦野市堀山下1番地 株式会社日
		立製作所エンタープライズサーバ事業部内
	(74)代理人	100077816
		弁理士 春日 譲
	Fターム(参	考) 30060 AA10 CB05 CB09
		(74)代理人

## (54) 【発明の名称】 分離切断方法及び装置

#### (57) 【要約】

【課題】基板の表面に溝を形成した後この溝にそって基 板を切断分離するスクライブ方式の基板の分離切断方式 において、製造時の切断誤差が小さく、製造歩留まりの 向上した分離切断装置を提供することにある。

【解決手段】ワーク30の表面には、スクライブ溝30 Sが形成されている。加圧ノズル40は、ワーク30の 裏面側からスクライブ溝30の部分に加圧されたエアを 吹きつける。また、加圧ノズル50,52は、ワーク3 0の表面側からスクライブ溝30Sの両側に加圧された エアを吹きつける。これによって、表面にスクライブ溝 の形成されたワークを、このスクライブ溝に沿って分離 切断する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】表面にスクライブ溝の形成されたワーク を、このスクライブ溝に沿って分離切断する分離切断方 法において、

上記ワークの裏面側から上記スクライブ溝をエアー加圧 して、上記ワークを分離切断することを特徴とする分離 切断方法。

【請求項2】表面にスクライブ溝の形成されたワーク を、このスクライブ溝に沿って分離切断する分離切断装 置において、

上記ワークの裏面側から上記スクライブ溝の部分に加圧 されたエアを吹きつける加圧ノズルと、

上記ワークの表面側から上記スクライブ溝の両側に加圧 されたエアを吹きつける加圧ノズルを備えたことを特徴 とする分離切断装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、分離切断方法及び 装置に係り、特に、セラミック基板などの電子回路に用 いられる回路基板等を分離切断するに好適な分離切断方 20 法及び装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】コンピュータや制御用回路基板等に用い られるセラミック基板は、一般的に、未焼結グリーンシ ートの穴明け、配線パターン等の印刷, 積層の後、焼結 して切断分離することにより製造されている。焼結後の 基板を切断する方法としては、従来は、砥石等により切 断するダイシングが通常用いられている。ダイシングの 際には、切断対象の基板は、接着剤等によりガラス等に 固定して行われる。ダイシング終了時点では、基板の裏 30 留まりを向上し得るものとなる。 にガラスが固定しているため、このガラスを取り外すに は、接着剤を溶融する工程や、溶融に用いた液洗浄する 工程が必要となっており、工程数が増すという問題があ った。また、基板の表面に薄膜導体パターン等が形成さ れている場合には、薄膜導体パターンの上に保護膜を形 成した後、ダイシングし、さらに、切断後、保護膜を除 去するT程が必要となる。

【0003】そこで、最近、ダイシング方式に代えて、 レーザビームにより、基板表面に溝を形成するスクライ ブ加工を行い、その後、この溝の部分の基板の裏側か ら、刃等を用いて押圧することにより、分離切断するス クライブ方式が注目されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、刃を用 いて押圧する方式について、本発明者らが検討をおこな ったところ、切断部の精度が悪いという問題があること が判明した。即ち、従来のダイシング方式では、切断線 に対して実際に切断される線の誤差は、±50μm程度 と小さいのに対して、溝を裏面から刃によって加圧する り、製造時の公差額囲に収まらず、製造時の歩留まりが 低下することが判明した。その理由について検討したと ころ、基板の表面に溝が形成されている場合、刃は、基 板の裏面から押し当てる必要があるため、刃を押し当て る位置の位置決め誤差が±200~300μmあるた め、この位置決め誤差によって、切断線の誤差も大きく なることが判明した。

2

【0005】本発明の目的は、基板の表面に溝を形成し た後この溝にそって基板を切断分離するスクライブ方式 10 の基板の分離切断方法及び装置において、製造時の切断 誤差が小さく、製造歩留まりの向上した分離切断方法及 び装置を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、表面にスクライブ溝の形成されたワーク を、このスクライブ溝に沿って分離切断する分離切断方 法において、上記ワークの裏面側から上記スクライブ溝 をエアー加圧して、上記ワークを分離切断するようにし たものである。

【0007】また、上記目的を達成するために、本発明 は、表面にスクライブ溝の形成されたワークを、このス クライブ溝に沿って分離切断する分離切断装置におい て、上記ワークの真面側から上記スクライブ溝の部分に 加圧されたエアを吹きつける加圧ノズルと、上記ワーク の表面側から上記スクライブ港の両側に加圧されたエア を吹きつける加圧ノズルを備えるようにしたものであ る。かかる方法及び構成により、吹きつけられた加圧エ アは、スクライブ溝の部分に応力集中して、ワークを切 断できるため、製造時の切断誤差を小さくでき、製造歩

### [8000]

【発明の実施の形態】以下、図1~図5を用いて、本発 明の一実施形態による分離切断装置の構成及び動作につ いて説明する。最初に、図1を用いて、本実施形態によ る分離切断装置に用いるレーザ加工装置の全体構成につ いて説明する。図1は、本発明の一実施形態による分離 切断装置に用いるレーザ加工装置の全体構成を示す斜視 図である。

【0009】レーザ発振器10から出射したレーザ光1 40 2は、ハーフミラー20Aにより、光路を分岐される。 レーザ発振器10としては、セラミック関連では、CO 2 レーザが適している。ハーフミラー20Aによって反 射されたレーザ光は、ミラー22Aによって反射されて ガルバノミラー24Aに導かれる。ガルバノミラー24 Aによって反射されたレーザ光は、f f レンズ26Aに よって、ワーク30上に集光される。fθレンズ26A は、斜め入射光に対し、垂直に光ビームを落射させる。 ガルバノミラー24Aは、矢印A方向に回動して、ワー ク30上のレーザ光の照射位置をスキャニングする。ハ 方式では、その誤差が±200~300μmと大きくな 50 ーフミラー20Aと、ミラー22Aの間のレーザ光路中

3 には、シャッター28Aが設けられており、シャッター

28Aを閉じることにより、ワーク30に対するレーザ 光の照射を停止することができる。

【0010】また、ハーフミラー20Aを透過したレー ザ光は、ハーフミラー20Bにより、光路を分岐され ろ、ハーフミラー20Aによって反射されたレーザ光 は、ミラー22Bによって反射されてガルバノミラー2 4 Bに導かれる。ガルバノミラー2 4 Bによって反射さ れたレーザ光は、fθレンズ26Bによって、ワーク3 0上に集光される。ガルバノミラー24Bは、矢印B方 10 向に回動して、ワーク30上のレーザ光の照射位置をス キャニングする。ハーフミラー20Bと、ミラー22B の間のレーザ光路中には、シャッター28Bが設けられ ている。

【0011】さらに、ハーフミラー20Bを透過したレ ーザ光は、ミラー200によって反射されて、ノズル2 1の中に配置されたレンズ23によって、ワーク30上 に集光される。ミラー200と、レンズ23の間のレー

ザ光路中には、シャッター28Cが設けられている。 工装置では、ハーフミラーを用いることにより、レーザ 発振器10から出射したレーザ光を、3つの加工光学系 に分岐し、ワーク30に照射することにより、それぞ れ、スクライブ加工、マーキング加工、切断加工に用い るようにしている。ここで、ワーク30は、例えば、焼 結後のセラミックグリーンシートである。スクライブ加 工は、ワーク30の表面に溝を形成し、この溝に沿って ワーク30の裏面から圧力を掛けることにより、ワーク 30をスクライブの溝に沿って分離切断するために用い られる。マーキング加工は、ワーク30の表面に印字す 30 ワーク30の厚さHが、例えば、1mmの場合、スクラ るものである。切断加工は、高出力のレーザ光により、 直接ワーク30を切断するものである。

【0013】レーザ発振器10の出力を200W程度と すると、スクライブ加工やマーキング加工の出力は5W 程度でよいため、ハーフミラー20A,20Bの反射率 を2~3%としている。即ち、ハーフミラー20A,2 OBの透過率は98~97%である。f θレンズ26A によって集光されたレーザ光は、例えば、スクライブ加 IScに用いられ、f θレンズ26Bによって集光され たレーザ光は、例えば、マーキング加工Maに用いられ 40 る。 もちろん、 f θ レンズ 2 6 Aによって集光されたレ ーザ光を、マーキング加工Maに用い、f θ レンズ 2 6 Bによって集光されたレーザ光を、スクライブ加工Sc に用いてもよいものである。レンズ23によって集光さ れたレーザ光の出力は、190W程度あるため、切断加 工Cuに用いられる。ワーク30は、XYステージ上に 固定されており、切断加工時の移動は、主として、ノズ ル21の移動によって行われる。スクライビングとマー キングは、ガルバノミラー24A, 24Bのスキャンニ ングによって行われる。

【0014】次に、図2を用いて、本実施形態による分 離切断装置によるブレイキング方法について説明する。 図2は、本発明の一実施形態による分離切断装置を用い たプレイキング方法を説明する側面図である。

【0015】最初に、図1に示したf f レンズ26Aを 用いて、レーザ光をワーク30の表面に集光して、基板 表面にスクライブ溝30Sを形成する。次に、スクライ ブ溝30Aの裏面より、加圧ジェットノズル40を用い て、加圧されたエアを滞位置裏に対し吹きつけ、加圧す る。このとき、ワーク30の裏面より、エアー加圧を行 うと、ワーク30が上へ浮き上がるので、ワーク30の 表面側であってスクライブ溝30Sの両端側に対して、 抑え加圧ノズル50、52から加圧されたエアを吹きつ けることにより、ワーク30の浮き上がりを防止する。 抑え加圧ノズル50、52から吹きつける加圧エアの圧 カは、加圧ジェットノズル40から吹きつけるエアの圧 カと同程度としている。スクライブ溝30Sの裏側から の加圧エアによる加圧によって、スクライブ溝30S に、曲げ広力が集中し、スクライブ溝30Sを開く力が 【0012】以上のようにして、本実施形態のレーザ加 20 はたらき、ワーク30の分離切断(プレイク)を行うこ とができる。

【0016】ここで、図3を用いて、本実施形態による ブレイキングの詳細について説明する。

【0017】図3は、本発明の一実施形態によるブレイ キングの詳細説明図である。

【0018】図3(A)に示すように、ワーク30の表 面には、スクライブ溝30Sが形成されている。スクラ イブ洗30は、幅W1で、深さD1である。ワーク30 が、例えば、焼結後のアルミナグリーンシートであり、 イブ溝30の幅W1は、例えば、0.1mmとし、深さ D1は、0、1mmとする。即ち、スクライブ溝30の 幅W1及び深さD1は、ワーク30の厚さHの10%程 度とする。

【0019】一方、加圧ジェットノズル40の先端に は、円形の関口部が形成されており、その直径Rは、例 えば、ø2mmとし、加圧エアーの圧力は、例えば、 5MPa (5kg/cm²) の場合、ワーク30と ノズル40の先端の距離Diを、1mmとしている。 【0020】ここで、スクライブ溝30Sが形成されて いる位置は、ワーク30の端部から距離し1離れている ものとする。ノズル40から吹きつけられる加圧エアー は、ワーク30に対して、スクライブ溝30Sが形成さ れている面と反対側から吹きつけられる。加圧エアの圧 力分布は、図3 (B) に示すように、ノズル40の中心 位置Cが一番高く、その周囲ほど圧力が低下するものと かっている。加圧エアの吹きつけ位置は、ワーク30の 端部を基準として位置決めされるが、その位置決めの際 の誤差により、端部から距離し2離れた位置になったと 50 すると、スクライプ溝30Sの中心位置と、ノズル40

10

から吹きつけられる加圧エアの圧力の中心位置には、位 置決め誤差∆Lが存在することになる。しかしながら、 ノズル40から吹きつけられた加圧エアによってワーク 30に作用する曲げ応力は、ワーク30が薄くなってい るスクライブ造30Sの形成されている部分の裏面側に 集中するため、スクライブ溝305の部分からワーク3

5

【0021】一方、図4は、従来の刃を用いて圧力を作 用させ、ワークを分離切断する場合について示してい

0を分離切断することができる。

【0022】ワーク30の表面には、スクライブ溝30 Sが形成されており、スクライブ溝30Sが形成されて いる位置は、ワーク30の端部から距離L1離れている ものとする。一方、ワーク30に対して応力を作用させ る刃100は、ワーク30の裏面から点Pに押しつけら れるものとする。ワーク30の端部から点Pまでの距離 をL2として、スクライブ溝30Sの中心位置と、刃1 00の押しつけられる位置との間に、位置決め誤差 △ L が存在する場合。 刃100からワーク30に作用する応 るため、誤差△Lが生じることになる。この位置決め誤 差 Δ L は、± 2 0 0 ~ 3 0 0 μ m あるため、従来の刃を 用いる方式では、切断時の誤差が大きく、製造歩留まり が低下するという問題があった。

【0023】一方、本実施形態では、スクライブ溝30 Sの中心位置と、ノズル40から吹きつけられる加圧エ アの圧力の中心位置に、位置決め誤差△Lが存在すると しても、ノズル40から吹きつけられた加圧エアによっ てワーク30に作用する曲げ応力は、スクライブ溝30 Sの形成されている部分の裏面側に集中するため、スク 30 きさの異なる小形基板を効率よく製造することができ ライブ溝30Sの部分から、±50μm程度の誤差以内 で、ワーク30を分離切断することができる。したがっ て、製造歩留まりを向上することができるものである。 【0024】なお、以上の説明では、ワーク30の厚さ Hを1mmとしているが、厚さに応じて、加圧エアーの 圧力は変える必要がある。例えば、ワーク30の厚さH を、2mmとした場合には、スクライブ溝30の幅W1 が、例えば、0.2mmで、深さD1が、0.2mmと する。そして、加圧ジェットノズル40の先端の円形の とノズル40の先端の距離Diを、1mmとした場合、 加圧エアーの圧力は、例えば、1MPa (10kg/c m¹)とし、とする。

【0025】また、ワーク30の材料として、アルミナ セラミックスの例で説明したが、他の材料でも、同様に 適用することができる。但し、分離切断時の条件は、ワ ーク30の材料によって異なってくる。例えば、ワーク 30の材料として、ムライトセラミックスを用いた場 合、ワーク30の厚さHが、例えば、1mmで、スクラ 1が、0.1mmとする。そして、加圧ジェットノズル 40の先端の円形の開口部の直径Rを、例えば、φ2m mとするとき、加圧エアーの圧力は、例えば、1MPa (10kg/cm²) とし、ワーク30とノズル40の 先端の距離Diを、1mmとする。

【0026】また、加圧ジェットノズル40の先端の開 口部の形状は円形に限らず、長円形としたり、線状とす ることもできる。なお、スクライブ溝30の幅W1及び 深さD1は、ワーク30の厚さHの10%程度とする。 【0027】次に、図5を用いて、本実施形態による分 離切断装置による他のブレイキング方法について説明す る。図5は、本発明の一実施形態による分離切断装置を 用いた他のプレイキング方法を説明する斜視図である。 なお、図1及び図2と同一符号は、同一部分を示してい

5. 【0028】本実施形態によるプレイキング方法は、一 直線にワークを分離切断する場合だけでなく、例えば、 L字形に分離するような2次元的な分離切断にも用いる ことができる。従来は、セラミックス基板から同一形状 力は、点Pに作用するため、点Pにおいて分離切断され 20 の基板を分離切断するのが一般的であるため、単に直線 的に (1次元的に) ワークを分離切断すればよいもので あった。しかしながら、セラミックス基板材料が高価な ことを考えると、できるだけ効率よく大型基板から所定 の基板を分離切断するようにするため、他種類の大きさ の異なる基板を大型基板に配置する方法が検討されてい る。このような大型基板から小形基板を分離切断する場 合には、一直線に分離切断する方式では、本来分離すべ きでない部分で切断されることになる。そこで、L字形 のように2次元的に分離切断できれば、大型基板から大

【0029】図5に示すように、ワーク30の表面に は、レンズ26Aによって集光されたレーザ光によっ て、スクライブ溝30S2が形成される。スクライブ溝 30 S 2 は、図示するように、L字形の遺である。 【0030】次に、スクライブ流30S2の裏面より、 加圧ジェットノズル40を用いて、加圧されたエアを溝 位置裏に対し吹きつけ、加圧する。このとき、ワーク3 0の表面には、ワーク30の浮き上がり防止のため、ワ 開口部の直径Rを、例えば、ゅ2mmとし、ワーク30 40 ーク30の表面側であってスクライブ溝30S2の両端 側に対して、抑え加圧ノズル50、52から加圧された エアを吹きつける。

> 【0031】さらに、ジェットノズル40をワーク30 の裏面側で移動させることによって、2次元的なブレイ クをする際には、ワーク30の浮き上がりを防止するた めに、さらに、複数の補助ノズル54A, 54B, 54 Cを用いて、ワーク30の表面側から加圧するようにす

【0032】ワーク30の表面側からの浮き上がり防止 イブ溝30の幅W1が、例えば、0.1mmで、深さD 50 によって、2次元的なブレイクも、スクライブ溝30S 7 2に、曲げ応力が集中し、スクライブ溝30S2を開く 力がはたらき、ワーク30の分離切断(プレイク)を行 うことができる。

[0033]

「発明の効果」本発明によれば、スクライブ方式で基板を分離切断する際に、切断誤差が小さく、製造歩留まり を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態による分離切断装置の全体 構成を示す斜視図である。

【図2】本発明の一実施形態による分離切断装置を用いたブレイキング方法を説明する側面図である。

【図3】本発明の一実施形態によるブレイキングの詳細 説明図である。

【図4】従来の刃を用いて圧力を作用させ、ワークを分\*

\*離切断する場合の説明図である。

【図5】本発明の一実施形態による分離切断装置を用い た他のブレイキング方法を説明する斜視図である。

【符号の説明】

10…レーザ発振器

12…レーザ光

20A, 20B…分岐ハーフミラー

21…ノズル

23…集光レンズ

10 24A, 24B…ガルバノスキャンミラー

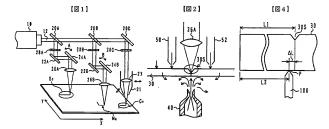
26A, 26B…f 0 レンズ

30…ワーク

40…加圧ジェットノズル

50,52…抑え加圧ノズル

54…補助加圧ノズル



[図5]

